

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成22年7月8日(2010.7.8)

【公開番号】特開2008-9425(P2008-9425A)

【公開日】平成20年1月17日(2008.1.17)

【年通号数】公開・登録公報2008-002

【出願番号】特願2007-147258(P2007-147258)

【国際特許分類】

G 02 F 1/1368 (2006.01)

G 02 F 1/1343 (2006.01)

【F I】

G 02 F 1/1368

G 02 F 1/1343

【手続補正書】

【提出日】平成22年5月25日(2010.5.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ボトムゲート型薄膜トランジスタと、
ITOからなる画素電極と、

前記ボトムゲート型薄膜トランジスタのソース領域またはドレイン領域の上部及び前記画素電極の上部に形成され、前記ボトムゲート型薄膜トランジスタと前記画素電極を接続するモリブデンからなる配線と、

前記画素電極上に形成された絶縁膜と、

前記絶縁膜上に形成された共通電極と、を有し、

前記画素電極と、前記共通電極との電位差に依存して液晶層の液晶分子の分子配列が変化することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】

ボトムゲート型薄膜トランジスタと、
ITOからなる画素電極と、

前記ボトムゲート型薄膜トランジスタのソース領域またはドレイン領域の上部及び前記画素電極の上部に形成され、前記ボトムゲート型薄膜トランジスタと前記画素電極を接続するモリブデンからなる配線と、

前記画素電極上に形成された窒化珪素膜からなる絶縁膜と、

前記絶縁膜上に形成された共通電極と、を有し、

前記画素電極と、前記共通電極との電位差に依存して液晶層の液晶分子の分子配列が変化することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項3】

ボトムゲート型薄膜トランジスタと、
ITOからなる画素電極と、

前記ボトムゲート型薄膜トランジスタのソース領域またはドレイン領域の上部及び前記画素電極の上部に形成され、前記ボトムゲート型薄膜トランジスタと前記画素電極を接続するモリブデンからなる配線と、

前記画素電極上に形成され、前記ボトムゲート型薄膜トランジスタのゲート絶縁膜にな

る窒化珪素膜からなる絶縁膜と、

前記絶縁膜上に形成された前記ボトムゲート型薄膜トランジスタの半導体膜と同時に形成された共通電極と、を有し、

前記画素電極と、前記共通電極との電位差に依存して液晶の液晶分子の分子配列が変化することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項4】

請求項1乃至3のいずれか一項に記載の液晶表示装置を表示部に用いた電子機器。

【請求項5】

請求項4において、

前記電子機器は、カメラ、ゴーグル型ディスプレイ、ナビゲーションシステム、カーオーディオ、オーディオコンポ等コンピュータ、ゲーム機器、モバイルコンピュータ、携帯電話、携帯型ゲーム機又は電子書籍であることを特徴とする液晶表示装置。